

# Silicon Diode

## **BYT78**

1000V / 3A

# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

## BYT 77 · BYT 78

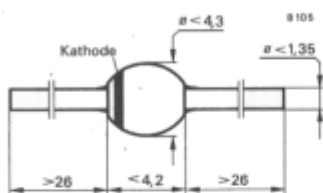
### Silizium-Mesa-Dioden

**Anwendungen:** Schneller "soft recovery" Gleichrichter

**Besondere Merkmale:**

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse

**Abmessungen in mm**



Sinterglasgehäuse  
SOD 64  
Gewicht max. 1,0 g

**Bestempfung:** Klartext

**Absolute Grenzdaten**

		BYT 77	BYT 78	
Sperrspannung	$U_R$	800	1000	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{FSM}$	100		A
Durchlaßstrom, Mittelwert $T_{amb} \leq 45 \text{ °C}$	Fig. 2, 5 $I_{FAV}$	3		A
Sperrschichttemperatur	$T_j$	175		°C
Lagerungstemperaturbereich	$T_{stg}$	- 65... + 175		°C

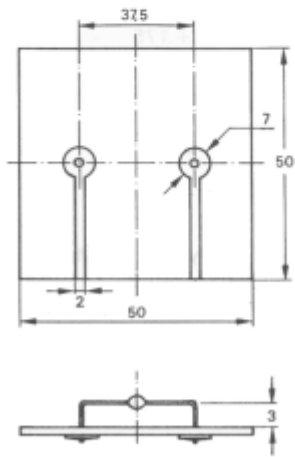
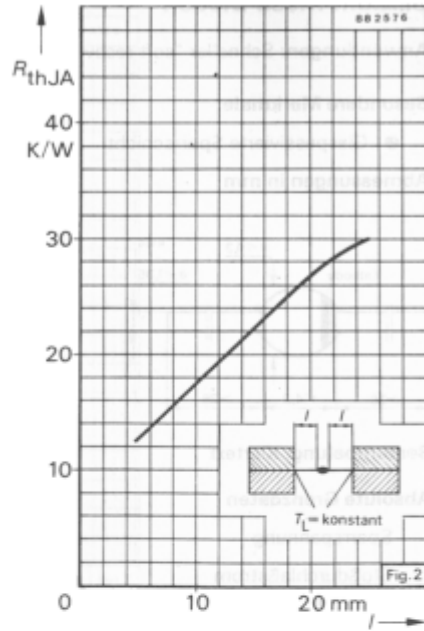
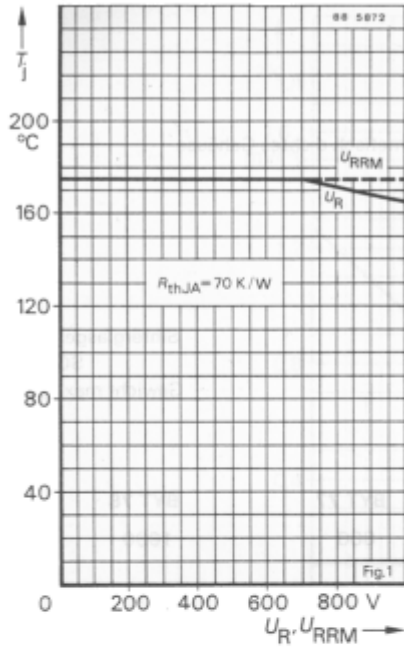
**Maximaler Wärmewiderstand**

Sperrschicht-Umgebung $l = 25 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$ auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm	Fig. 2	$R_{thJA}$	30	K/W
	Fig. 3	$R_{thJA}$	70	K/W

**Kenngrößen**

		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25 \text{ °C}$ , falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 3 \text{ A}$	$U_F$		1,0	1,1	V
Sperrstrom					
$U_R$	$I_R$		1	5	$\mu\text{A}$
$U_{R'} T_j = 150 \text{ °C}$	$I_R$		60	150	$\mu\text{A}$
Rückwärtserholzeit $I_F = 0,5 \text{ A}, I_R = 1 \text{ A}, i_R = 0,25 \text{ A}$	$t_{rr}$			300	ns

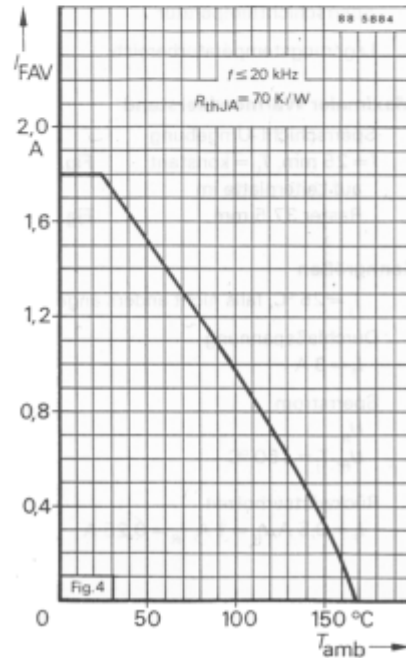
**BYT 77 · BYT 78**



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm  
 $R_{thJA} \leq 70 \text{ K/W}$

Fig.3

88 5875



**BYT 77 · BYT 78**

